

6 mirror microlithography projection system

Patent number: DE10037870
Publication date: 2002-02-14
Inventor: MANN HANS-JUERGEN (DE); DINGER UDO (DE);
MUEHLBEYER MICHAEL (DE)
Applicant: ZEISS CARL (DE)
Classification:
- international: **G02B17/06; G03F7/20; G02B17/00; G03F7/20; (IPC1-7): G02B5/08; G03F7/20**
- european: G02B17/06C2; G03F7/20T16
Application number: DE20001037870 20000801
Priority number(s): DE20001037870 20000801

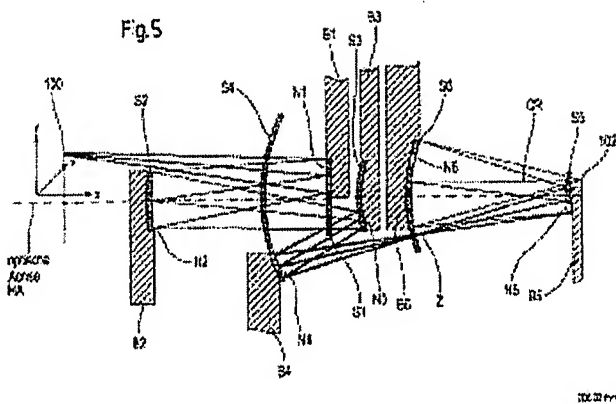
Also published as:

EP1178356 (A2)
EP1178356 (A3)
EP1178356 (B1)

[Report a data error here](#)

Abstract not available for DE10037870
Abstract of corresponding document: **EP1178356**

A projection lens uses short waves, preferably ≤ 193 nm, with entrance and exit pupils for representing an object field in an image field displaying a section of a ring field. This section has a symmetry axis and an expansion of at least 20 mm but preferably 25 mm vertical to the symmetry axis. Six mirrors (S1-S6) form a structure centred on an optical axis. Each mirror has a useful range (N1-N6), in which rays of light fall that are guided by the projection lens.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 100 37 870 A 1**

⑤① Int. Cl.⁷:
G 02 B 5/08
G 03 F 7/20

②① Aktenzeichen: 100 37 870.6
②② Anmeldetag: 1. 8. 2000
④③ Offenlegungstag: 14. 2. 2002

DE 100 37 870 A 1

⑦① Anmelder:
Carl Zeiss, 89518 Heidenheim, DE

⑦④ Vertreter:
Dr. Weitzel & Partner, 89522 Heidenheim

⑦② Erfinder:
Mann, Hans-Jürgen, Dr., 73447 Oberkochen, DE;
Dinger, Udo, Dr., 73447 Oberkochen, DE;
Mühlbeyer, Michael, 73430 Aalen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ 6-Spiegel-Mikrolithographie-Projektionsobjektiv

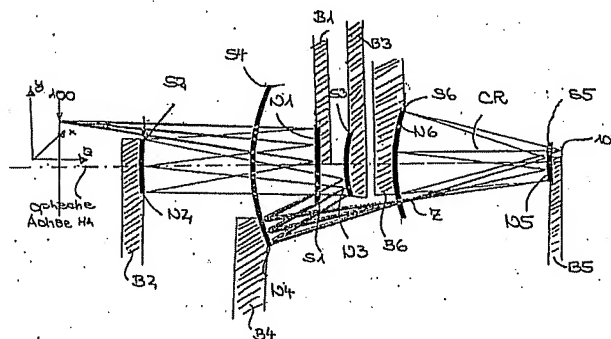
⑤⑦ Die Erfindung betrifft ein Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, vorzugsweise ≤ 193 nm mit einer Eintrittspupille und einer Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm, ist,

- einem ersten (S1), einem zweiten (S2), einem dritten (S3), einem vierten (S4), einem fünften (S5) und einem sechsten Spiegel (S6) in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse, wobei

- jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreffen; sowie

- einer numerischen Apertur an der Austrittspupille größer als 0,1, bevorzugt größer als 0,2, besonderes bevorzugt größer als 0,23.

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels ≤ 300 mm ist.



DE 100 37 870 A 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mikrolithographieobjektiv gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, eine Projektionsbelichtungsanlage gemäß Anspruch 21 sowie ein Chipherstellungsverfahren gemäß Anspruch 22.

- 5 [0002] Die Lithographie mit Wellenlängen < 193 nm, insbesondere die EUV-Lithographie mit $\lambda = 11$ nm bzw. $\lambda = 13$ nm werden als mögliche Techniken zur Abbildungen von Strukturen < 130 nm, besonders bevorzugt < 100 nm diskutiert. Die Auflösung eines lithographischen Systems wird durch nachfolgende Gleichung beschrieben:

$$10 \quad RES = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$$

wobei k_1 ein spezifischer Parameter des Lithographieprozesses, λ die Wellenlänge des einfallenden Lichtes und NA die bildseitige, numerische Apertur des Systems bezeichnet.

- 15 [0003] Für abbildende Systeme im EUV-Bereich stehen als optische Komponenten im wesentlichen reflektive Systeme mit Multilayer-Schichten zur Verfügung. Als Multilayer-Schichtsysteme finden bei $\lambda = 11$ nm bevorzugt Mo/Be-Systeme und bei $\lambda = 13$ nm Mo/Si-Systeme Verwendung.

[0004] Legt man eine numerische Apertur von 0,2 zugrunde, so erfordert die Abbildung von 50-nm-Strukturen mit 13-nm-Strahlung einen vergleichsweise einfachen Prozeß mit $k_1 = 0,77$. Mit $k_1 = 0,64$ wird bei 11-nm-Strahlung die Abbildung von 35-nm-Strukturen möglich.

- 20 [0005] Da die Reflektivität der eingesetzten Multilayer-Schichten nur im Bereich von ungefähr 70% liegt, ist es bei den Projektionsobjektiven für die EUV-Mikrolithographie von ganz entscheidender Bedeutung, zum Erreichen einer ausreichenden Lichtstärke mit möglichst wenig optischen Komponenten im EUV-Projektionsobjektiv auszukommen.

[0006] Als besonders bevorzugt haben sich mit Blick auf eine hohe Lichtintensität und ausreichende Möglichkeiten zur Korrektur von Abbildungsfehlern bei NA = 0,20 Systeme mit sechs Spiegeln herausgestellt.

- 25 [0007] 6-Spiegel-Systeme für die Mikrolithographie sind aus den Druckschriften US-A-5 153 898, EP-A-0 252 734, EP-A-0 947 882, US-A-5686728, EP 0 779 528, US 5 815 310, WO 99/57606 und US 6 033 079 bekannt geworden.

[0008] Das Projektions-Lithographiesystem gemäß der US-A-5 686 728 zeigt ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln, wobei jede der reflektiven Spiegelflächen asphärisch ausgebildet ist. Die Spiegel sind entlang einer gemeinsamen optischen Achse so angeordnet, daß ein obskurationsfreier Lichtweg erreicht wird.

- 30 [0009] Da das aus der US-A-5 686 728 bekannte Projektionsobjektiv nur für UV-Licht mit einer Wellenlänge von 100–300 nm eingesetzt wird, weisen die Spiegel dieses Projektionsobjektives eine sehr hohe Asphärizität von ungefähr ± 50 μ m sowie sehr große Einfallswinkel von ca. 38° auf. Auch nach Abblenden auf NA = 0,2 verbleibt hier eine Asphärizität von 25 μ m von Spitze zu Spitze bei kaum vermindertem Einfallswinkel. Derartige Asphärizitäten und Einfallswinkel sind im EUV-Bereich wegen der hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität, Reflektivität der Spiegel nicht praktikabel.

[0010] Ein weiterer Nachteil des aus der US-A-5 686 728 bekannt gewordenen Objektives, der einen Einsatz im Bereich von $\lambda < 100$ nm, insbesondere bei den Wellenlängen von 11 und 13 nm nicht mehr erlaubt, ist der sehr geringe Abstand zwischen dem Wafer und dem dem Wafer am nächsten liegenden Spiegel. Bei den aus der US-A-5 686 728 bekannt gewordenen Abständen von Wafer und wafernächstem Spiegel können die Spiegel nur sehr dünn ausgebildet werden. Wegen der extremen Schicht-Spannungen in den Multilayer-Systemen für die angesprochenen Wellenlängen von 11 und 13 nm sind derartige Spiegel sehr instabil.

- 40 [0011] Aus der EP-A-0 779 528 ist ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln zum Einsatz in der EUV-Lithographie, insbesondere auch bei Wellenlängen von 13 nm und 11 nm, bekanntgeworden.

[0012] Auch dieses Projektionsobjektiv hat den Nachteil, daß mindestens zwei der insgesamt sechs Spiegel sehr hohe Asphärizitäten von 26 bzw. 18,5 μ m aufweisen. Insbesondere ist aber auch bei der aus der EP-A-0779528 bekannten Anordnung der optische freie Arbeitsabstand zwischen wafernächstem Spiegel und Wafer derart gering, daß es entweder zu Instabilitäten oder aber einem mechanisch freien Arbeitsabstand, der negativ ist, kommt.

- 45 [0013] Aus der WO 99/57606 ist ein 6-Spiegel-Projektionsobjektiv für die EUV-Lithographie mit einer Spiegelabfolge konkav-konkav-konvex-konkav-konvex-konkav gezeigt, das eine numerische Apertur am Objekt $NA_{\text{Objekt}} = 0,2$ aufweist. Alle Spiegel des aus der WO 99/57606 bekannten Systems sind asphärisch ausgebildet.

[0014] Nachteilig an dem aus der WO 99/57606 bekannten 6-Spiegel-Objektiv ist, daß eine leichte Zugänglichkeit der Nutzbereiche beispielsweise für eine Einfassung insbesondere am zweiten und dritten Spiegel nicht gegeben ist.

- 50 [0015] Des weiteren ist der Nutzbereich des vierten Spiegels bei dem aus der WO 99/57606 bekannten System weit außerhalb der optischen Achse angeordnet. Dies führt zu Problemen in bezug auf die Stabilität des Spiegelsystems und bei der Herstellung dieses Spiegelsegmentes. Auch wird ein großer umbauter Raum benötigt, um das System zu kapseln. Da das System im Vakuum eingesetzt wird, ist ein relativ großer Raum zu evakuieren. Die gemäß der WO99/57606 zwischen dem zweiten und dem dritten Spiegel angeordnete Blende hat große Inzidenzwinkel auf dem dritten Spiegel zur Folge, die insbesondere größer als 18° sind.

- 60 [0016] Aus der US 6033079 ist ein 6-Spiegel-System bekannt, bei dem die Inzidenzwinkel auf allen Spiegeln kleiner als 18° sind. Allerdings hat auch dieses System den Nachteil, daß der Nutzbereich des dritten Spiegels nicht zugänglich ist und die Nutzbereiche einzelner Spiegel, beispielsweise des vierten Spiegels (M4) so groß sind, daß wie bei dem aus der WO 99/57606 bekannten System ein großer umbauter Raum benötigt wird, was wiederum einen relativ großen zu evakuierenden Raum zur Folge hat. Ein weiterer Nachteil von relativ großen Spiegeln ist deren mangelnde Stabilität und die Tatsache, daß entsprechend große Beschichtungskammern und Fertigungsmaschinen für deren Herstellung benötigt werden.

65 [0017] Aufgabe der Erfindung ist es somit, eine für die Lithographie mit kurzen Wellenlängen, vorzugsweise kleiner 100 nm, geeignetes Projektionsobjektiv anzugeben, das die zuvor erwähnten Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist, insbesondere soll ein Projektionsobjektiv angegeben werden, das sich durch möglichst geringe Abmessungen

und eine gute Zugänglichkeit des Nutzbereiches eines jeden Spiegels auszeichnet.

[0018] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, vorzugsweise ≤ 193 nm gelöst, das eine Eintrittspupille und eine Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist, einen ersten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften und einen sechsten Spiegel in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse, wobei jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreffen umfasst, wobei der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels ≤ 300 mm ist.

[0019] Die numerische Apertur an der Austrittspupille des erfindungsgemäßen Objektivs ist größer als 0,1, bevorzugt größer als 0,2, besonders bevorzugt größer als 0,23.

[0020] Die Zugänglichkeit der einzelnen Spiegel des Objektivs, insbesondere zum Zwecke der Einfassung der Spiegel wird in einer fortgebildeten Ausführungsform gewährleistet, wenn der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel jeweils einen rückwärtigen Bauraum aufweist, der entlang der optischen Achse gemessen von der Spiegelvorderseite im Nutzbereich eine Tiefe aufweist, wobei die Tiefe jeweils des ersten, zweiten, dritten, vierten und sechsten Bauraumes mindestens 50 mm und die Tiefe des Bauraumes des fünften Spiegels größer als 1/3 des Wertes des Durchmessers des fünften Spiegels ist und sich die jeweiligen Bauräume nicht durchdringen.

[0021] Besonders vorteilhaft mit Blick auf die Zugänglichkeit ist es, wenn alle Bauräume in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird.

[0022] Ein besonders stabiles System im Hinblick auf die schichtspannungsinduzierten Randdeformationen erhält man, wenn der Randbereich umlaufend um den Nutzbereich aller Spiegel mehr als 4 mm beträgt, wobei die Lichtführung im Objektiv obskurationsfrei erfolgt.

[0023] Die Beschichtung der Spiegelsubstrate mit den zuvor erwähnten Mo/Be- oder Mo/Si-Vielfachschichtsystemen haben oftmals Spannungen zur Folge, die besonders am Rand des Substrates zu Deformationen führen können. Ein ausreichend großer Randbereich verhindert, daß diese sich in den Nutzbereich des Spiegels fortsetzen.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform liegt der Nutzbereich des vierten Spiegels geometrisch zwischen zweitem Spiegel und der Bildebene.

[0025] Besonders bevorzugt ist es, wenn der vierte Spiegel geometrisch zwischen drittem und zweitem Spiegel, insbesondere zwischen erstem und zweitem Spiegel angeordnet ist. Eine derartige Anordnung hat besonders geringe Abmessungen der Nutzbereiche des ersten, zweiten, dritten und vierten Spiegels zur Folge.

[0026] Der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von viertem und erstem Spiegel (S4 S1) zum Abstand von zweitem und erstem Spiegel (S2 S1) liegt vorteilhafterweise im Bereich

$$0,1 < \frac{(S4 S1)}{(S2 S1)} < 0,9$$

und der Abstand von drittem und zweitem Spiegel (S2 S3) zum Abstand von viertem zu drittem Spiegel (S4 S3) im Bereich

$$0,3 < \frac{(S3 S4)}{(S2 S3)} < 0,9$$

[0027] Um die Winkelbelastung auf den Spiegeln gering zu halten, ist vorteilhafterweise vorgesehen, daß der Einfallswinkel des Hauptstrahles des Feldpunktes, der auf der Symmetrieachse in der Mitte des Objektfeldes liegt, auf allen Spiegeln $< 18^\circ$ ist.

[0028] In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung weist das Projektionsobjektiv ein Zwischenbild auf, wobei das Zwischenbild vorteilhafterweise im Projektionsobjektiv in der Lichtrichtung nach dem vierten Spiegel ausgebildet wird.

[0029] In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung ist der erste Spiegel konvex und alle sechs Spiegel sind asphärisch ausgebildet.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der erste Spiegel konkav und alle sechs Spiegel asphärisch ausgebildet.

[0031] Alternativ hierzu kann der erste Spiegel paraxial plan und alle sechs Spiegel asphärisch ausgebildet sein.

[0032] Eine gegenüber einer Ausgestaltung der Erfindung, bei der alle Spiegel asphärisch ausgebildet sind, besonders einfache Fertigbarkeit ergibt sich, wenn höchstens fünf Spiegel asphärisch sind.

[0033] Besonders bevorzugt ist es, wenn der Spiegel mit dem von der optischen Achse am entferntesten liegenden Nutzbereich, das ist in der Regel der vierte Spiegel, sphärisch ausgebildet ist.

[0034] Neben dem Projektionsobjektiv stellt die Erfindung auch eine Projektionsbelichtungsanlage zur Verfügung, wobei die Projektionsbelichtungsanlage eine Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung eines Ringfeldes sowie ein Projektionsobjektiv gemäß der Erfindung umfasst.

[0035] Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Ausführungsbeispiele beschrieben werden.

[0036] Es zeigen:

[0037] Fig. 1 den Nutzbereich eines Spiegels

[0038] Fig. 2 das Ringfeld in der Objektebene des Objektivs

[0039] Fig. 3 die Definition des Bauraumes für zwei beliebige Spiegel des Projektionsobjektivs

[0040] Fig. 4 eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektivs mit sechs asphärischen Spiegeln, wobei der erste Spiegel konvex ausgebildet ist

[0041] Fig. 5 eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln, wobei der erste Spiegel konkav ausgebildet ist

[0042] Fig. 6a-6f der Nutzbereich sämtlicher sechs Spiegel eines Projektionsobjektives gemäß Fig. 4

[0043] Fig. 7 eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln, wobei der erste Spiegel paraxial plan ausgebildet ist

[0044] Fig. 8 eine vierte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit fünf asphärischen und einem sphärischen Spiegel, wobei der vierte Spiegel sphärisch ausgebildet ist

[0045] Fig. 9 der prinzipielle Aufbau einer Projektionsbelichtungsanlage mit einem erfindungsgemäßen Objektiv.

[0046] In Fig. 1 ist dargestellt, was in der vorliegenden Anmeldung unter Nutzbereich und Durchmesser des Nutzbereiches zu verstehen ist.

[0047] Fig. 1 zeigt beispielhaft für ein ausgeleuchtetes Feld 1 auf einem Spiegel des Projektionsobjektives ein Feld in Nierenform. Eine derartige Form wird für den Nutzbereich bei Verwendung des erfindungsgemäßen Objektives in einer Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage erwartet. Der Hüllkreis 2 umschließt die Nierenform völlig und fällt an zwei Punkten 6, 8 mit dem Rand 10 der Nierenform zusammen. Der Hüllkreis ist stets der kleinste Kreis, der den Nutzbereich umfasst. Der Durchmesser D des Nutzbereiches ergibt sich dann aus dem Durchmesser des Hüllkreises 2.

[0048] In Fig. 2 ist das Objektfeld 11 einer Projektionsbelichtungsanlage in der Objektebene des Projektionsobjektives dargestellt, das mit Hilfe des erfindungsgemäßen Projektionsobjektives in eine Bildebene, in der ein lichtempfindliches Objekt, beispielsweise ein Wafer angeordnet ist, abgebildet wird. Das Objektfeld 11 hat die Gestalt eines Segmentes eines Ringfeldes. Das Segment weist eine Symmetrieachse 12 auf.

[0049] Des weiteren sind in Fig. 2 die die Objektebene aufspannenden Achsen, nämlich die x-Achse und die y-Achse eingezeichnet. Wie aus Fig. 2 zu entnehmen, verläuft die Symmetrieachse 12 des Ringfeldes 11 in Richtung der y-Achse. Gleichzeitig fällt die y-Achse mit der Scan-Richtung einer EUV-Projektionsbelichtungsanlage, die als Ringfeldscanner ausgelegt ist, zusammen. Die x-Richtung ist dann die Richtung, die innerhalb der Objektebene senkrecht auf der Scan-Richtung steht.

[0050] In Fig. 3 sind beispielhaft für das Gesamtsystem zwei Spiegelsegmente 20, 22 eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives gezeigt, wobei die Spiegelsegmente 20, 22 mit den Nutzbereichen des Spiegels korrespondieren. Die Spiegelsegmente sind entlang einer optischen Achse 24 angeordnet. Wie aus Fig. 3 des weiteren ersichtlich, ist jedem Nutzbereich 20, 22 eines Spiegels des Projektionsobjektives ein Bauraum 26, 28 zugeordnet. Unter der Tiefe T des Bauraumes wird in vorliegender Anmeldung die Ausdehnung des Bauraumes vom Mittelpunkt 30, 32 des Nutzbereichs 20, 22 eines jeden Spiegels parallel zur optischen Achse verstanden. Als Mittelpunkt des Nutzbereiches wird in vorliegender Anmeldung der Auftreffpunkt des Hauptstrahles CR des zentralen Feldpunktes des Objektfeldes auf den Nutzbereich des jeweiligen Spiegels verstanden. Wie in Fig. 3 dargestellt sind die Spiegel im Projektionsobjektiv derart angeordnet, daß sich die Bauräume 26, 28 geometrisch nicht durchdringen.

[0051] In Fig. 4 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen 6-Spiegel-Systems gezeigt, wobei die Größe des abzubildenden Objektes, das das Segment eines Ringfeldes darstellt und eine Symmetrieachse wie in Fig. 2 dargestellt aufweist, in Richtung senkrecht zur Symmetrieachse mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist. Das abzubildende Objekt befindet sich in der Objektebene 100 des in der Fig. 4 dargestellten Objektives. In der Objektebene 100 wird als Objektfeld in vorliegendem Beispiel ein Ringfeldsegment ausgebildet. Desweiteren ist in der Objektebene das auf eine lichtempfindliche Schicht abzubildende Objekt, das in der Lithographie auch als Retikel bezeichnet wird, angeordnet.

[0052] Die Ebene, in die das Objekt 100 durch das erfindungsgemäße Projektionsobjektiv abgebildet wird, ist die Bildebene 102, in der beispielsweise ein Wafer angeordnet sein kann. Das erfindungsgemäße Projektionsobjektiv umfaßt einen ersten Spiegel S1, einen zweiten Spiegel S2, einen dritten Spiegel S3, einen vierten Spiegel S4, einen fünften Spiegel S5 sowie einen sechsten Spiegel S6. Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel sind sämtliche sechs Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 und S6 als asphärische Spiegel ausgebildet. Bei dem ersten Spiegel S1 handelt es sich um einen Konkav-Spiegel.

[0053] Die Blende B ist bei dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 auf dem zweiten Spiegel S2 angeordnet. Das System ist zur optischen Achse HA zentriert und bildseitig, d. h. in der Bildebene 102 telezentrisch. Unter bildseitiger Telezentrie versteht man, daß der Hauptstrahl CR unter einem Winkel von nahe oder ungefähr 90° auf die Bildebene 102 trifft.

[0054] Um die Lichtverluste und die beschichtungsinduzierten Wellenfrontaberrationen innerhalb des Spiegelsystems möglichst gering zu halten, ist der Auftreffwinkel des Hauptstrahles CR des zentralen Feldpunktes auf die jeweilige Spiegeloberfläche stets kleiner als 18°. In Fig. 4 ebenfalls eingezeichnet sind die Bauräume B1, B2, B3, B4, B5 und B6 der Nutzbereiche N1, N2, N3, N4, N5 und N6 der jeweiligen Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 und S6.

[0055] Wie aus Fig. 4 deutlich zu erkennen, ist das Gesamtobjektiv derart aufgebaut, daß alle Bauräume B1, B2, B3, B4, B5 und B6 in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse 12 des in der Ebene 100 liegenden Objektfeldes ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird. Zur leichteren Lesbarkeit ist in Fig. 4 ein Koordinatensystem x, y, z eingezeichnet. Die optische Achse des Objektives verläuft in z-Richtung, das Objektfeld liegt in der x-y-Objektebene und die Symmetrieachse des Objektfelds 100 weist in y-Richtung.

[0056] Wie aus Fig. 4 hervorgeht sind die Bauräume aller Nutzbereiche in Richtung der Symmetrieachse 10 des Objektfeldes ausdehnbar. Dies stellt sicher, daß die Spiegel von wenigstens einer Seite des Objektives her zugänglich sind und beispielsweise eingefast und montiert werden können.

[0057] Des weiteren handelt es sich bei dem Ausführungsbeispiel 1 gemäß Fig. 4 um ein System mit Zwischenbild Z. Das Zwischenbild Z wird geometrisch nach dem ersten Spiegel S1 zwischen viertem und fünftem Spiegel S4, S5 ausgebildet. Durch das Zwischenbild Z wird das System gemäß Fig. 4 in zwei Teilsysteme, ein erstes Teilsystem umfassend die Spiegel S1, S2, S3 und S4 sowie in ein zweites Teilsystem umfassend die Spiegel S5 und S6 geteilt.

[0058] Der Bauraum B1 bis B4 und B6 der Spiegel S1 bis S4 und S6 beträgt mindestens 50 mm, der Bauraum B5 des fünften Spiegels mindestens ein Drittel des Durchmessers des Nutzbereichs des fünften Spiegels, so daß ein freier Arbeitsabstand zwischen dem wafemächsten fünften Spiegel S5 und der Bildebene 102 von mindestens 12 mm garantiert

wird.

[0059] Die Code-V-Daten des ersten Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 4 sind in Tabelle 1, die im Anhang wiedergegeben ist, angegeben. Hierbei bezeichnet die Element-Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Spiegel S1, S2, S3, S4, S5 sowie S6.

[0060] Die bildseitige numerische Apertur des Systems gemäß Ausführungsbeispiel 1 beträgt 0,25.

[0061] In Fig. 5 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Gleiche Bauteile wie in Fig. 4 sind mit denselben Bezugsziffern belegt. Wiederum sind alle sechs Spiegeloberflächen asphärisch, im Gegensatz zur Ausführungsform gemäß Fig. 4 ist jedoch der erste Spiegel S1 nicht konvex, sondern konkav ausgebildet.

[0062] Die Daten des Systems sind in der in Tabelle 2 im Anhang der Anmeldung wiedergegebenen Code-V-Tabelle angegeben. Die numerische Apertur des Projektionsobjektives gemäß Fig. 5 beträgt wie schon im Falle der ersten Ausführungsform gemäß Fig. 4 $NA = 0,25$.

[0063] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 sind erfindungsgemäß die Durchmesser D der Nutzbereiche aller im Objektiv angeordneten Spiegel kleiner als 300 mm, wobei das abzubildende Objekt das Segment eines Ringfeldes ist, wie in Fig. 2 dargestellt.

[0064] Die Nutzbereiche in der x-y-Ebene der jeweiligen Spiegel des zweiten Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 5 ist in den Fig. 6a bis 6f gezeigt. In allen Abbildungen eingezeichnet ist das x-y-Koordinatensystem, wie durch die Objektebene definiert. Hierbei bezeichnet die y-Richtung die Richtung in Richtung der Scan-Richtung eines Ringfeldscanners und die x-Richtung die Richtung senkrecht zur Scan-Richtung.

[0065] Wie aus Fig. 6a hervorgeht, ist der Nutzbereich N1 auf dem Spiegel S1 im wesentlichen nierenförmig und weist einen Durchmesser D wie in Fig. 1 definiert, von 145,042 mm auf. Der Durchmesser des Nutzbereiches N2 auf dem Spiegel S2 ist im wesentlichen kreisförmig, der Durchmesser beträgt 157,168 mm gemäß Fig. 6b.

[0066] Beim Spiegel S3 ist der Nutzbereich N3 wiederum nierenförmig, der Durchmesser D beträgt 102,367 mm gemäß Fig. 6c und beim Spiegel S4 weist der Nutzbereich N4 gemäß Fig. 6d einen Durchmesser von 222,497 mm auf.

[0067] Die Nutzbereiche N5 und N6 gemäß den Fig. 6e und 6f auf den Spiegeln S5 und S6 sind im wesentlichen kreisförmig, der Durchmesser D des Nutzbereiches N5 beträgt 83,548 mm und der Durchmesser D des Nutzbereiches N6 270,054 mm.

[0068] Erfindungsgemäß ist somit der Durchmesser sämtlicher Nutzbereiche N1 bis N6 der Ausführungsform des Projektionsobjektives gemäß Fig. 5 kleiner als 300 mm.

[0069] In Fig. 7 ist eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Projektionsobjektives mit sechs asphärischen Spiegeln gezeigt. Wiederum sind für gleiche Bauteile wie in den Fig. 4 und 6 dieselben Bezugsziffern verwendet. Die Daten der dritten Ausführungsform gemäß Fig. 7 sind in der im Anhang wiedergegebenen Tabelle 3 im Code-V-Format angegeben. Die numerische Apertur des Systems gemäß Fig. 7 beträgt $NA = 0,25$. Der erste Spiegel S1 des Ausführungsbeispiels in Fig. 7 ist paraxial plan ausgebildet. Hierunter versteht man in der vorliegenden Anmeldung, daß die Grundkrümmung des Spiegels S1 in der Nähe der optischen Achse HA identisch Null ist.

[0070] Ein aus Fertigungsgesichtspunkten besonders vorteilhaftes 6-Spiegel-System zeigt Fig. 8. Bei dem System gemäß Fig. 8 beträgt die numerische Apertur 0,23, der vierte Spiegel ist ein sphärischer Spiegel, was unter Fertigungsgesichtspunkten sehr vorteilhaft ist, da sphärische Flächen leichter als asphärische Flächen zu bearbeiten sind und der vierte Spiegel S4 der Spiegel mit dem am weitesten von der optischen Achse entfernten Nutzbereich ist.

[0071] Die Daten des Systems gemäß Fig. 8 sind in Tabelle 4 im Anhang im Code-V-Format wiedergegeben.

[0072] Für die relativ geringen Abmessungen der Nutzbereiche der Spiegel, insbesondere des vierten Spiegels, ist die Lage des vierten Spiegels geometrisch zwischen drittem und zweitem bzw. erstem und zweitem Spiegel im Projektionsobjektiv verantwortlich.

[0073] Die Daten betreffend die Lage des vierten Spiegels in bezug auf den zweiten und ersten Spiegel bzw. den zweiten und dritten Spiegel werden durch nachfolgende Bedingungen beschrieben:

$$0,1 < \frac{(S4, S1)}{(S2, S1)} < 0,9 \quad (1)$$

$$0,3 < \frac{(S3, S4)}{(S2, S3)} < 0,9 \quad (2)$$

[0074] Bevorzugt gilt für Bedingung (2):

$$0,4 < \frac{(S3, S4)}{(S2, S3)} < 0,9 \quad (2a)$$

[0075] Diese Bedingungen sind für die vier Ausführungsbeispiele in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben.

Tabelle 5

Daten zur Bedingung (1)

Ausführungs- beispiel	Eigenschaft	(S4S1)/ (S2S1)
1 = Figur 4	M1 konvex	0.14
2 = Figur 5	M1 konkav	0.35
3 = Figur 7	M1 plan	0.19
4 = Figur 8	NA = 0.23, 5 Asphären	0.67

Tabelle 6

Daten zur Bedingung (2)

Ausführungs- beispiel	Eigenschaft	(S3S4)/ (S2S3)
1 = Figur 4	M1 konvex	0.31
2 = Figur 5	M1 konkav	0.44
3 = Figur 7	M1 plan	0.34
4 = Figur 8	NA = 0.23, 5 Asphären	0.69

[0076] Der Durchmesser der Nutzbereiche ist insbesondere deswegen ein wichtiger Parameter, da sie die Abmessungen der Objektivkammer festlegen. Große Nutzbereiche und damit große Spiegel beanspruchen einen sehr großen Bau-
raum, was unter dem Gesichtspunkt der Evakuierung eines größeren UHV-Systems nachteilhaft ist. Ein weiterer Nach-
teil großer Spiegel ist deren größere Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Schwingungen, da ihre Eigenfrequenz
kleiner ist als bei kleineren Spiegeln. Ein weiterer Vorteil von Spiegeln mit geringen Abmessungen liegt darin, daß die
Asphärisierung und Beschichtung der Substrate in kleineren UHV-Bearbeitungskammern erfolgen kann.

[0077] Da die Beschichtung der Spiegelsubstrate mit den Vielfachschichtsystemen zu Schichtspannungen führen, kön-
nen insbesondere am Rand des Substrates Deformationen auftreten. Damit diese sich nicht in den Nutzbereich des Spie-
gels fortsetzen, ist es notwendig, außerhalb des Nutzbereiches einen Mindestüberlauf vorzusehen, innerhalb dessen die
Deformationen abklingen können. Der Randbereich der einzelnen Spiegel in den Ausführungsbeispielen 1 bis 4 ist in
nachfolgender Tabelle 7 wiedergegeben.

Tabelle 7

Daten zu den Randbereichen der Spiegel S1 bis S6

Spiegel	A1 = Figur 4	A2 = Figur 5	A3 = Figur 7	A4 = Figur 8
S1	13 mm	21 mm	16 mm	2 mm
S2	11 mm	11 mm	8 mm	8 mm
S3	22 mm	28 mm	26 mm	8 mm
S5	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
S6	5 mm	6 mm	5 mm	2 mm

[0078] Wie hieraus zu ersehen ist, beträgt der Randbereich bei den Ausführungsformen gemäß **Fig. 4, 5 und 7** für jeden Spiegel mehr als 4 mm, was für die fassungstechnische Berücksichtigung von Schichtspannungen besonders vorteilhaft ist.

[0079] In **Fig. 9** ist eine Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie mit einem erfindungsgemäßen 6-Spiegel-Projektionsobjektiv **200** dargestellt. Das Beleuchtungssystem **202** kann wie beispielsweise in der EP 99106348.8 mit dem Titel "Beleuchtungssystem, insbesondere für die EUV-Lithographie" oder US-Serial No 09/ 305,017 mit dem Titel "Illumination system particularly for EUV-Lithography" beschrieben, deren Offenbarungsgehalt vollumfänglich in die vorliegende Anmeldung mit aufgenommen wird, ausgebildet sein. Ein derartiges Beleuchtungssystem umfasst eine EUV-Lichtquelle **204**. Das Licht der EUV-Lichtquelle wird vom Kollektorspiegel **206** gesammelt. Mit Hilfe eines ersten Spiegels **207** umfassend Rasterelemente – sogenannte Feldwaben – und eines zweiten Spiegels **208** umfassend Rasterelemente – sogenannte Pupillenwaben – sowie eines Spiegels **210** wird das Retikel **212** beleuchtet. Das vom Retikel **212** reflektierte Licht wird mittels des erfindungsgemäßen Projektionsobjektives auf einen Träger **214** umfassend eine lichtempfindliche Schicht abgebildet.

[0080] Mit der Erfindung wird somit erstmals ein Projektionsobjektiv mit sechs Spiegeln angegeben, das sich durch Nutzbereiche mit geringen Abmessungen auf allen Spiegeln auszeichnet und insoweit ein aus konstruktionstechnischer und fertigungstechnischer Sicht besonders vorteilhaftes, kompaktes Projektionsobjektiv darstellt.

Anhang

Tabellen 1-4

Code-V-Objektivdaten

Tabelle 1

Ausführungsbeispiel 1 (Fig. 4)

ELEMENT NUMMER	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART
OBJEKT	INF	743.3276		
1	A(1)	-557.1863	210.8986	REFL
		APERTURBLENDE	177.1640	
		0.0000		
2	A(2)	702.9968	177.3847	REFL
3	A(3)	-221.1310	191.0743	REFL
4	A(4)	787.9929	426.0706	REFL
5	A(5)	-436.7697	110.1796	REFL
6	A(6)	480.7697	310.6813	REFL
BILD	INF		70.5007	

ASPHÄRISCHE KONSTANTEN

$Z = \frac{(CURV)Y^2}{1 + (1-(1+K)(CURV)^2 Y^2)^{1/2}} + (A)Y^4 + (B)Y^6 + (C)Y^8 + (D)Y^{10} + (E)Y^{12} + (F)Y^{14} + (G)Y^{16} + (H)Y^{18} + (J)Y^{20}$						
ASPHÄRE	CURV	K E	A F	B G	C H	D J
A(1)	0.00006144	0.000000 1.87256E-29	5.48969E-10 0.00000E+00	-4.47710E-15 0.00000E+00	6.93597E-20 0.00000E+00	-1.61832E-24 0.00000E+00
A(2)	0.00092955	0.000000 -7.88639E-30	-4.50667E-11 0.00000E+00	-3.63055E-16 0.00000E+00	-3.52050E-21 0.00000E+00	7.46570E-26 0.00000E+00
A(3)	0.00284106	0.000000 1.64447E-27	-3.98337E-10 0.00000E+00	-2.92857E-15 0.00000E+00	8.46286E-19 0.00000E+00	-5.98614E-23 0.00000E+00
A(4)	0.00193867	0.000000 -1.71616E-31	-3.55491E-12 0.00000E+00	7.43877E-17 0.00000E+00	-5.36969E-22 0.00000E+00	2.36533E-26 0.00000E+00
A(5)	0.00179551	0.000000 -9.96256E-26	5.44569E-09 0.00000E+00	1.45719E-13 0.00000E+00	-5.07132E-18 0.00000E+00	1.13331E-21 0.00000E+00
A(6)	0.00186905	0.000000 4.44608E-32	6.69863E-11 0.00000E+00	3.06114E-16 0.00000E+00	1.29123E-21 0.00000E+00	2.82784E-27 0.00000E+00

REFERENZWELLENLÄNGE = 13.4 NM
 ABBILDUNGSMASSTAB = 0.25
 BILDEITIGE APERTUR = 0.25

Tabelle 2

Ausführungsbeispiel 2 (Fig. 5)

ELEMENT NUMMER	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART	
OBJEKT	INF	753.1539			5
1	A(1)	-508.8959	217.5892	REFL	
		APERTURZLENDE	157.2988		
		0.0000			10
2	A(2)	592.9977	157.6458	REFL	
3	A(3)	-253.0251	186.9465	REFL	
4	A(4)	357.5155	464.9979	REFL	
5	A(5)	-437.1855	110.6968	REFL	
6	A(6)	481.2681	311.8894	REFL	
BILO	INF		70.8868		15

ASPHÄRISCHE KONSTANTEN

$$Z = \frac{(CURV)Y^2}{1 + (1-K)(CURV)Y^2} + (A)Y^4 + (B)Y^6 + (C)Y^8 + (D)Y^{10} + (E)Y^{12} + (F)Y^{14} + (G)Y^{16} + (H)Y^{18} + (J)Y^{20}$$

ASPHÄRE	CURV	K E	A F	B G	C H	D J	
A(1)	-0.00009342	0.000000 3.09845E-29	5.02048E-10 0.00000E+00	-3.59798E-15 0.00000E+00	4.65491E-20 0.00000E+00	-1.24487E-24 0.00000E+00	30
A(2)	0.00094495	-0.000000 0.00000E+00	-8.64008E-11 0.00000E+00	-8.21885E-16 0.00000E+00	-7.41356E-21 0.00000E+00	-3.30260E-25 0.00000E+00	
A(3)	0.00281349	0.000000 -3.93860E-27	-8.95729E-10 0.00000E+00	1.08088E-14 0.00000E+00	-1.55198E-18 0.00000E+00	1.20451E-22 0.00000E+00	35
A(4)	0.00176899	0.799352 -1.67295E-30	-6.05769E-10 0.00000E+00	-1.14820E-15 0.00000E+00	-3.64542E-20 0.00000E+00	2.50132E-25 0.00000E+00	
A(5)	0.00182078	0.000000 -8.77929E-26	5.28849E-09 0.00000E+00	1.32507E-13 0.00000E+00	-2.78314E-18 0.00000E+00	7.00685E-22 0.00000E+00	40
A(6)	0.00186581	0.000000 5.80814E-32	6.68738E-11 0.00000E+00	3.06141E-16 0.00000E+00	1.34385E-21 0.00000E+00	1.39691E-27 0.00000E+00	

REFERENZWELLENLÄNGE = 13.4 NM
 ABBILDUNGSMASSTAB = 0.25
 BILDSEITIGE APERTUR = 0.25

Tabelle 3

Ausführungsbeispiel 3 (Fig. 7)

5	ELEMENT NUMMER	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART		
	OBJEKT	INF	767.2557				
	1	A(1)	-555.7033	216.0671	REFL		
10			APERTURBLENDE	173.9832			
	2	A(2)	0.0000				
	3	A(3)	682.2766	174.2476	REFL		
	4	A(4)	-233.6859	188.2262	REFL		
	5	A(5)	794.6148	428.4357	REFL		
	6	A(6)	-436.8293	110.5239	REFL		
15	BILD	INF	480.8400	310.5587	REFL		
				70.4765			
ASPHÄRISCHE KONSTANTEN							
20	$Z = \frac{(CURV)^2}{1 + (1 - (1 + K)(CURV)^2)^{1/2}} + (A)Y^4 + (B)Y^6 + (C)Y^8 + (D)Y^{10} + (E)Y^{12} + (F)Y^{14} + (G)Y^{16} + (H)Y^{18} + (J)Y^{20}$						
25	ASPHÄRE	CURV	K E	A F	B G	C H	D J
30	A(1)	0.00000000	0.000000 2.03931E-29	5.67634E-10 0.00000E+00	-4.28505E-15 0.00000E+00	6.16577E-20 0.00000E+00	-1.42715E-24 0.00000E+00
	A(2)	0.00092352	0.000000 -7.88639E-30	-4.50667E-11 0.00000E+00	-3.63055E-16 0.00000E+00	-3.52050E-21 0.00000E+00	7.46570E-26 0.00000E+00
35	A(3)	0.00277871	0.000000 1.08438E-27	-3.26329E-10 0.00000E+00	-7.02528E-16 0.00000E+00	5.33788E-19 0.00000E+00	-3.92007E-23 0.00000E+00
	A(4)	0.00188296	0.000000 -6.94542E-31	-9.51406E-12 0.00000E+00	5.06179E-16 0.00000E+00	-9.93523E-21 0.00000E+00	1.33054E-25 0.00000E+00
	A(5)	0.00185628	0.000000 -1.05073E-25	5.15785E-09 0.00000E+00	1.54832E-13 0.00000E+00	-5.20812E-18 0.00000E+00	1.16863E-21 0.00000E+00
40	A(6)	0.00186897	0.000000 6.23447E-32	6.62264E-11 0.00000E+00	2.99098E-16 0.00000E+00	1.29774E-21 0.00000E+00	1.07497E-27 0.00000E+00
45	REFERENZWELLENLÄNGE =		13.4 NM				
	ABBILDUNGSMASSTAB =		0.25				
	BILDSEITIGE APERTUR =		0.25				

Tabelle 4

Ausführungsbeispiel 4 (Fig. 8)

ELEMENT NUMMER	RADIUS	DICKE	DURCHMESSER	ART			

OBJEKT	INF	739.9848					
1	A(1)	-559.9848	188.6091	REFL			
		APERTURZLENDE	219.3872		10		
		0.0000					
2	A(2)	709.9848	219.1277	REFL			
3	A(3)	-492.0904	179.7699	REFL			
4	847.3874 CC	1094.5501	577.4446	REFL			
5	A(4)	-412.2537	109.4460	REFL			
6	A(5)	452.2537	273.6442	REFL			
BILD	INF		71.0012		15		

ASPHÄRISCHE KONSTANTEN							
						20	
$Z = \frac{(CURV)Y^2}{1 + (1 - (1 + K)(CURV)^2 Y^2)^{1/2}} + (A)Y^4 + (B)Y^6 + (C)Y^8 + (D)Y^{10} + (E)Y^{12} + (F)Y^{14} + (G)Y^{16} + (H)Y^{18} + (J)Y^{20}$						25	
ASPHÄRE	CURV	K E	A F	B G	C H	D J	

A(1)	0.00046523	0.000000 -3.23697E-28	-7.36323E-11 0.00000E+00	1.86189E-15 0.00000E+00	-7.73130E-20 0.00000E+00	8.54337E-24 0.00000E+00	30
A(2)	0.00092527	-0.000000 0.00000E+00	-5.11521E-11 0.00000E+00	-3.80687E-16 0.00000E+00	-3.05582E-21 0.00000E+00	-7.83597E-27 0.00000E+00	
A(3)	0.00241893	0.000301 7.76365E-28	5.01337E-10 0.00000E+00	2.76322E-15 0.00000E+00	1.65053E-19 0.00000E+00	-1.79843E-23 0.00000E+00	35
A(4)	0.00112101	0.000000 2.29050E-25	6.42053E-09 0.00000E+00	6.30201E-15 0.00000E+00	6.16162E-18 0.00000E+00	-2.15921E-21 0.00000E+00	
A(5)	0.00192607	0.000000 0.00000E+00	1.40503E-10 0.00000E+00	8.32770E-16 0.00000E+00	3.64734E-21 0.00000E+00	5.66305E-26 0.00000E+00	40

REFERENZWELLENLÄNGE =		13.4	NM				
ABBILDUNGSMASSTAB =		0.25					
BILDSEITIGE APERTUR =		0.23					45

Patentansprüche

1. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für kurze Wellenlängen, vorzugsweise ≤ 193 nm mit einer Eintrittspupille und einer Austrittspupille zur Abbildung eines Objektfeldes in ein Bildfeld, das das Segment eines Ringfeldes darstellt, wobei das Segment eine Symmetrieachse und eine Ausdehnung senkrecht zur Symmetrieachse aufweist und die Ausdehnung mindestens 20, bevorzugt 25 mm ist,

1.1 einem ersten (S1), einem zweiten (S2), einem dritten (S3), einem vierten (S4), einem fünften (S5) und einem sechsten Spiegel (S6) in zentrierter Anordnung zu einer optischen Achse, wobei

1.2 jeder dieser Spiegel einen Nutzbereich aufweist, in dem die Lichtstrahlen, die durch das Projektionsobjektiv geführt werden, auftreffen; sowie

1.3 einer numerischen Apertur an der Austrittspupille größer als 0,1, bevorzugt größer als 0,2, besonders bevorzugt größer als 0,23,

dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des Nutzbereiches des ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Spiegels ≤ 300 mm ist.

2. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel jeweils einen rückwärtigen Bauraum aufweist, der parallel zur optischen Achse gemessen von der Spiegelvorderseite im Nutzbereich eine Tiefe aufweist, wobei die Tiefe jeweils des ersten, zweiten, dritten, vierten und sechsten Bauraumes mindestens 50 mm und die Tiefe des Bauraumes des fünften Spiegels größer als 1/3 des Wertes des Durchmessers des fünften Spiegels ist, wobei sich die jeweiligen Bauräume nicht durchdringen.

3. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß alle Bauräume in eine Richtung parallel zur Symmetrieachse ausdehnbar sind, ohne daß der Lichtweg im Objektiv oder der Bauraum eines anderen Spiegels geschnitten wird.

4. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel einen Randbereich umlaufend um den Nutzbereich umfasst und der Randbereich mehr als 4 mm beträgt, wobei die Lichtführung im Objektiv obskurationsfrei erfolgt.

5. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Nutzbereich des vierten Spiegels geometrisch zwischen zweitem Spiegel und der Bildebene angeordnet ist.

6. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der vierte Spiegel geometrisch zwischen drittem und zweitem Spiegel angeordnet ist.

7. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der vierte Spiegel geometrisch zwischen erstem und zweitem Spiegel angeordnet ist.

8. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von viertem und erstem Spiegel (S4 S1) zum Abstand von zweitem und erstem Spiegel (S2 S1) im Bereich

$$0,1 < \frac{(S4 S1)}{(S2 S1)} < 0,9$$

liegt.

9. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Spiegelscheitel entlang der optischen Achse von drittem und zweitem Spiegel (S2 S3) zum Abstand von viertem zu drittem Spiegel (S4 S3) im Bereich

$$0,3 < \frac{(S3 S4)}{(S2 S3)} < 0,9$$

liegt.

10. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Einfallswinkel des Hauptstrahles des Feldpunktes, der auf der Symmetrieachse in der Mitte des Objektfeldes liegt auf allen Spiegeln $< 18^\circ$ ist.

11. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß im Projektionsobjektiv in der Lichtrichtung nach dem vierten Spiegel (S4) ein Zwischenbild ausgebildet wird.

12. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine Blende (B) im Lichtweg bzw. Strahlengang auf dem zweiten Spiegel (S2) angeordnet ist.

13. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Spiegel konvex und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.

14. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Spiegel paraxial flach und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.

15. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Spiegel konkav und der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Spiegel asphärisch ausgebildet sind.

16. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß sämtliche Spiegel asphärisch ausgebildet sind.

17. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß höchstens fünf Spiegel asphärisch sind.

18. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß der vierte Spiegel sphärisch ausgebildet ist.

19. Mikrolithographie-Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite bis sechste Spiegel (S2 S6) in der Reihenfolge konkav-konvex-konkav-konvex-konkav ausgebildet ist.

20. Mikrolithographie-Projektionsobjektiveinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Objektiv bildseitig telezentrisch ist.

21. Projektionsbelichtungsanlage, dadurch gekennzeichnet, daß die Projektionsbelichtungsanlage eine Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung eines Ringfeldes sowie ein Projektionsobjektiv gemäß einem der Ansprüche 1 bis 20 umfasst.

22. Verfahren zur Chipherstellung mit einer Projektionsbelichtungsanlage gemäß Anspruch 21.

Hierzu 11 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

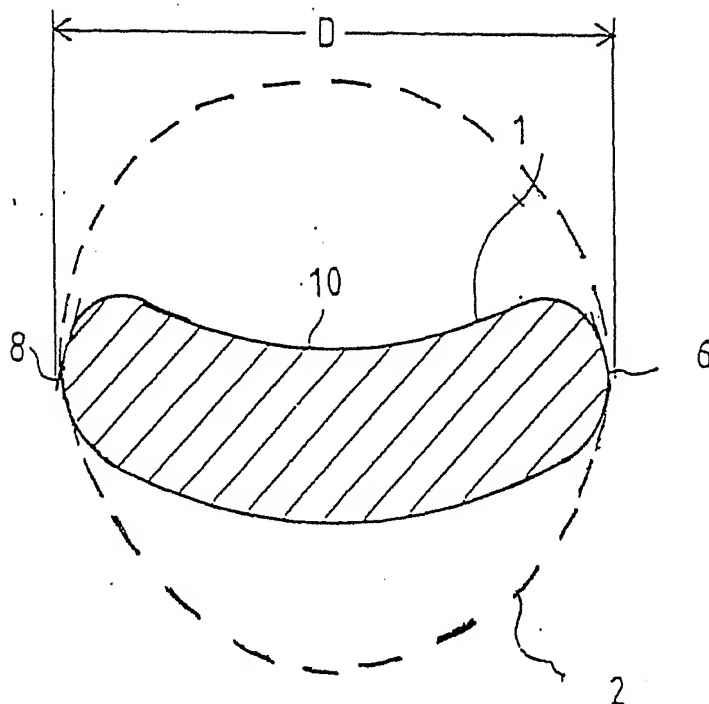
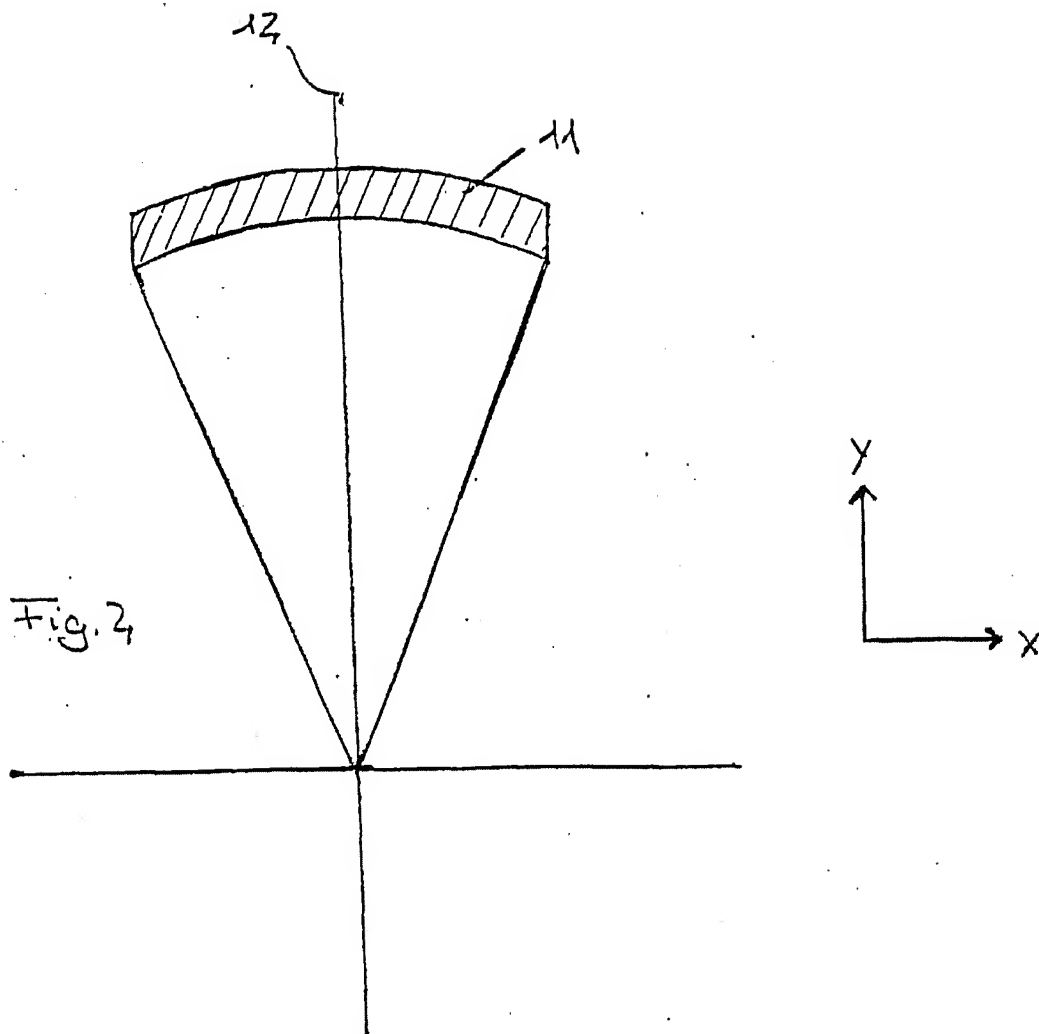
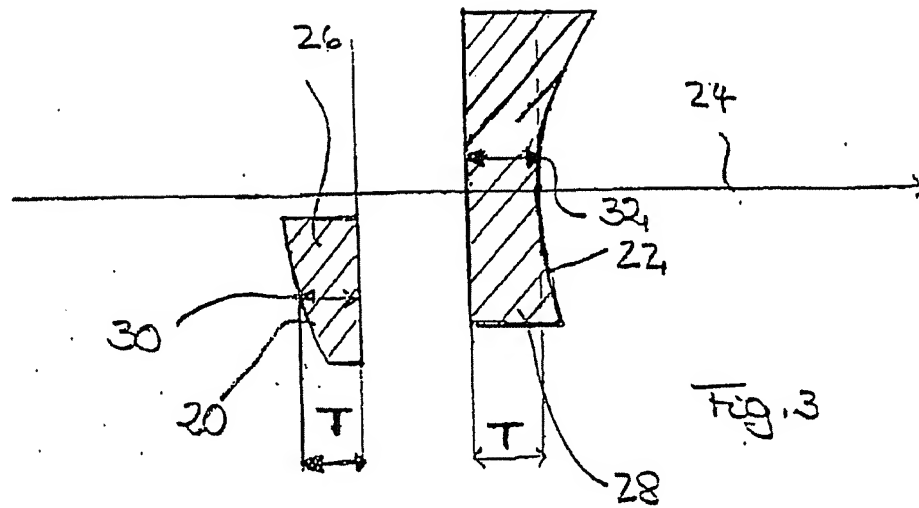


FIG. 1





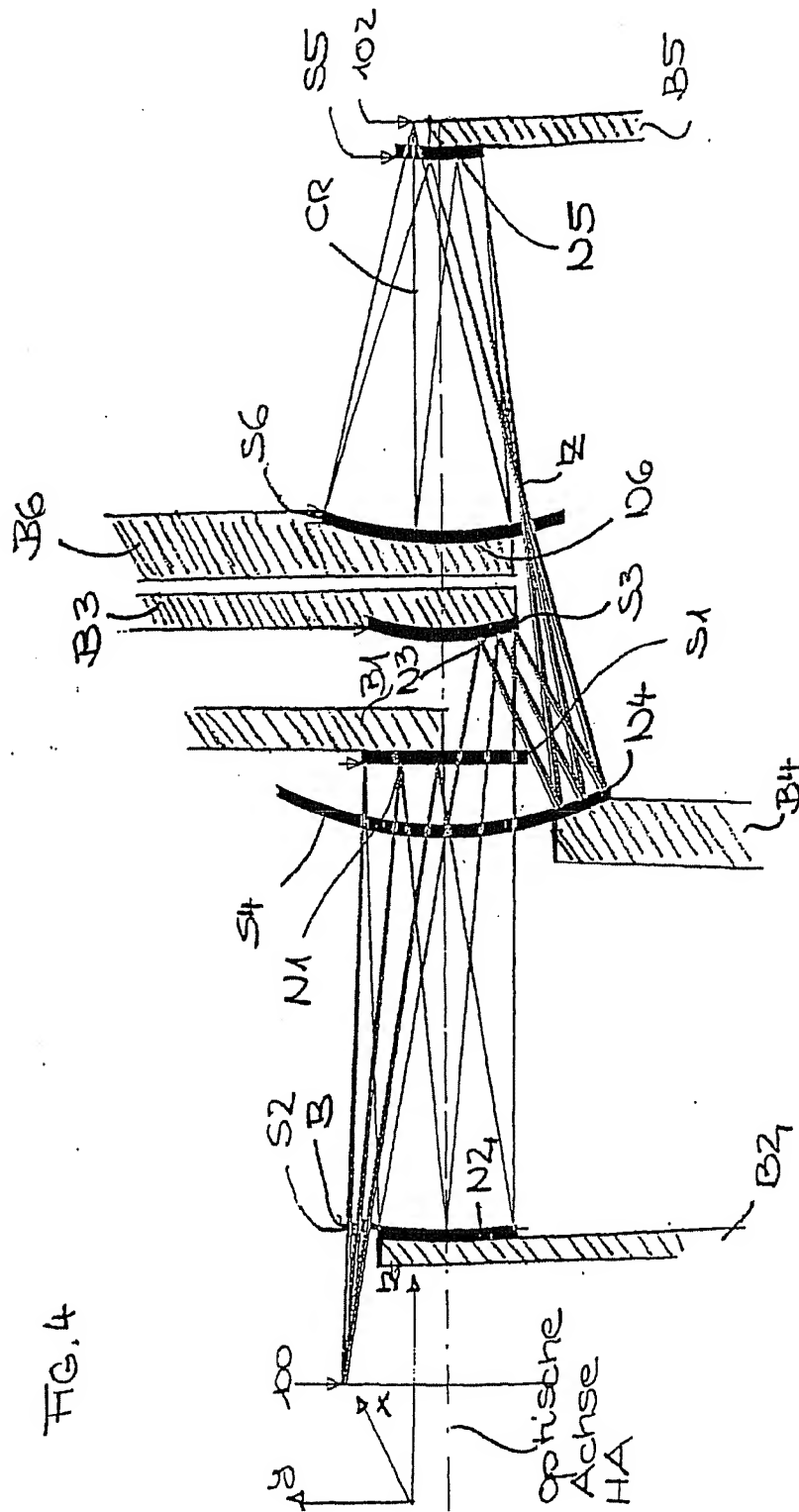
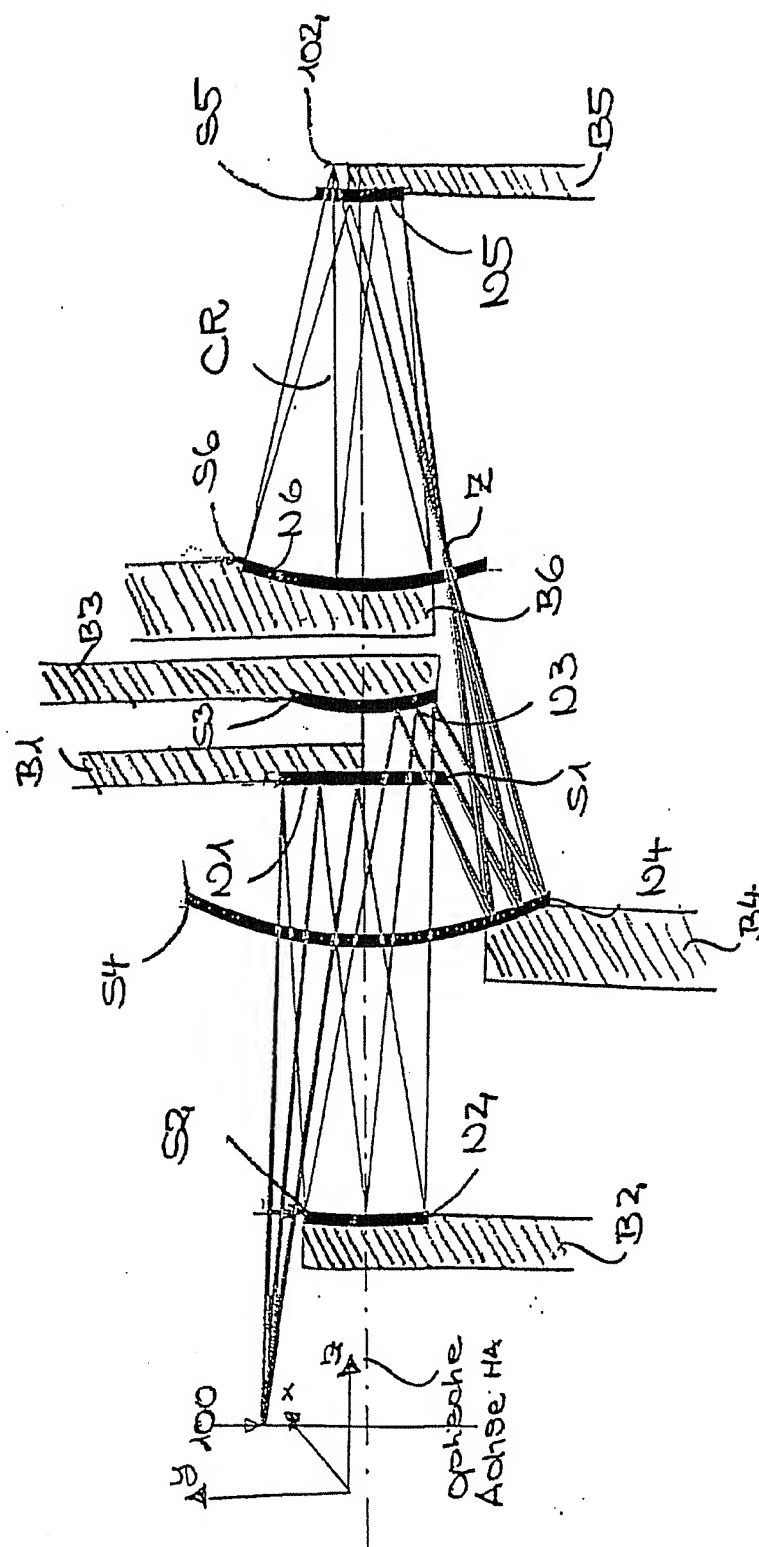


Fig. 5



208.33 NM

S1

N1

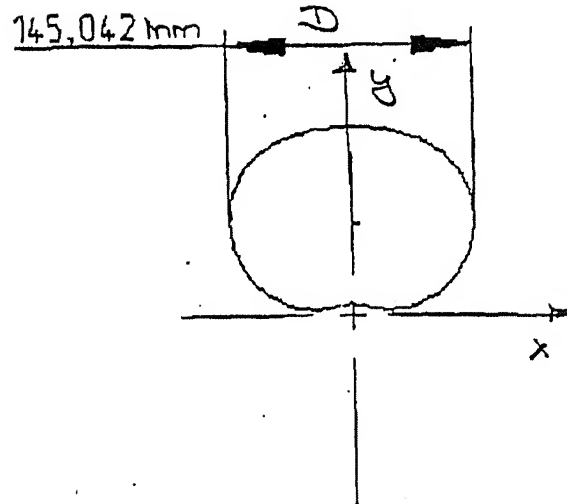


Fig. 6a

S2

N2

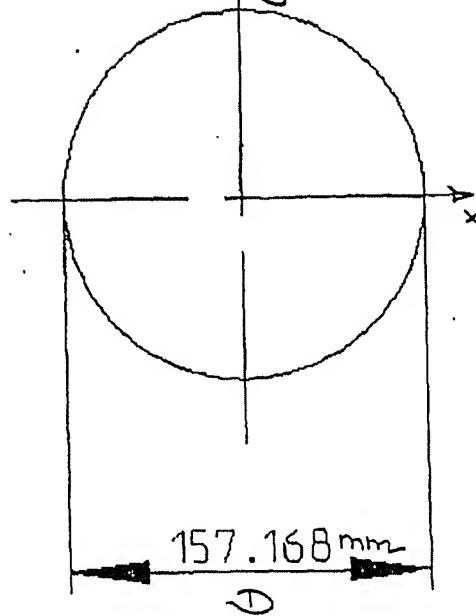


Fig. 6b

S3

N3

Fig. 6a

102.367 mm

D

S4

N4

Fig. 6d

222.497 mm

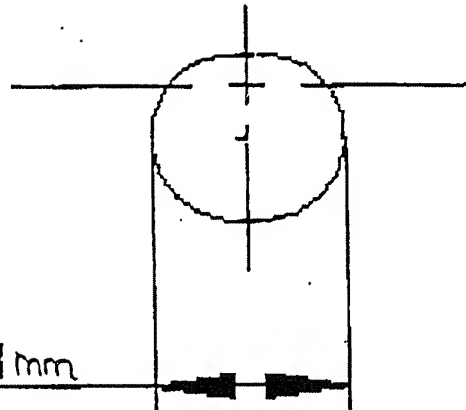
D

S5

N5

Fig. 6e

83.548 mm



S6

N6

Fig. 6f

270.054 mm

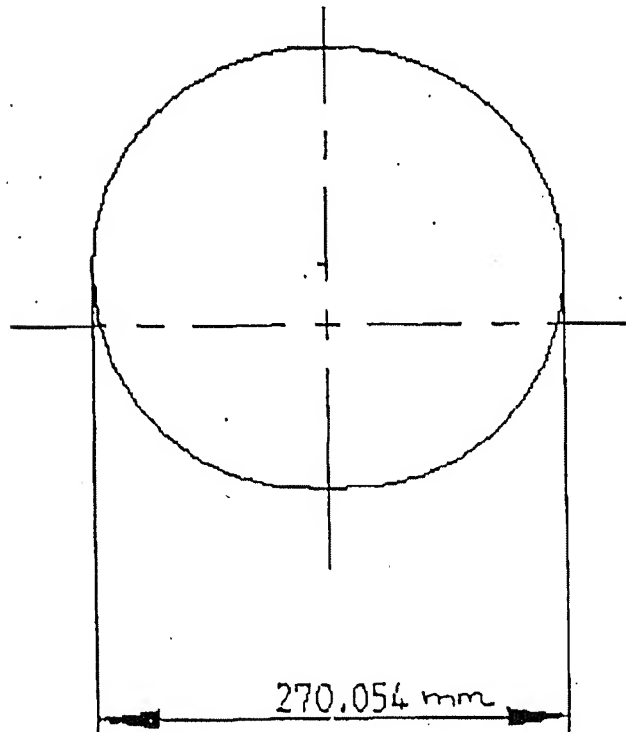


Fig. 7

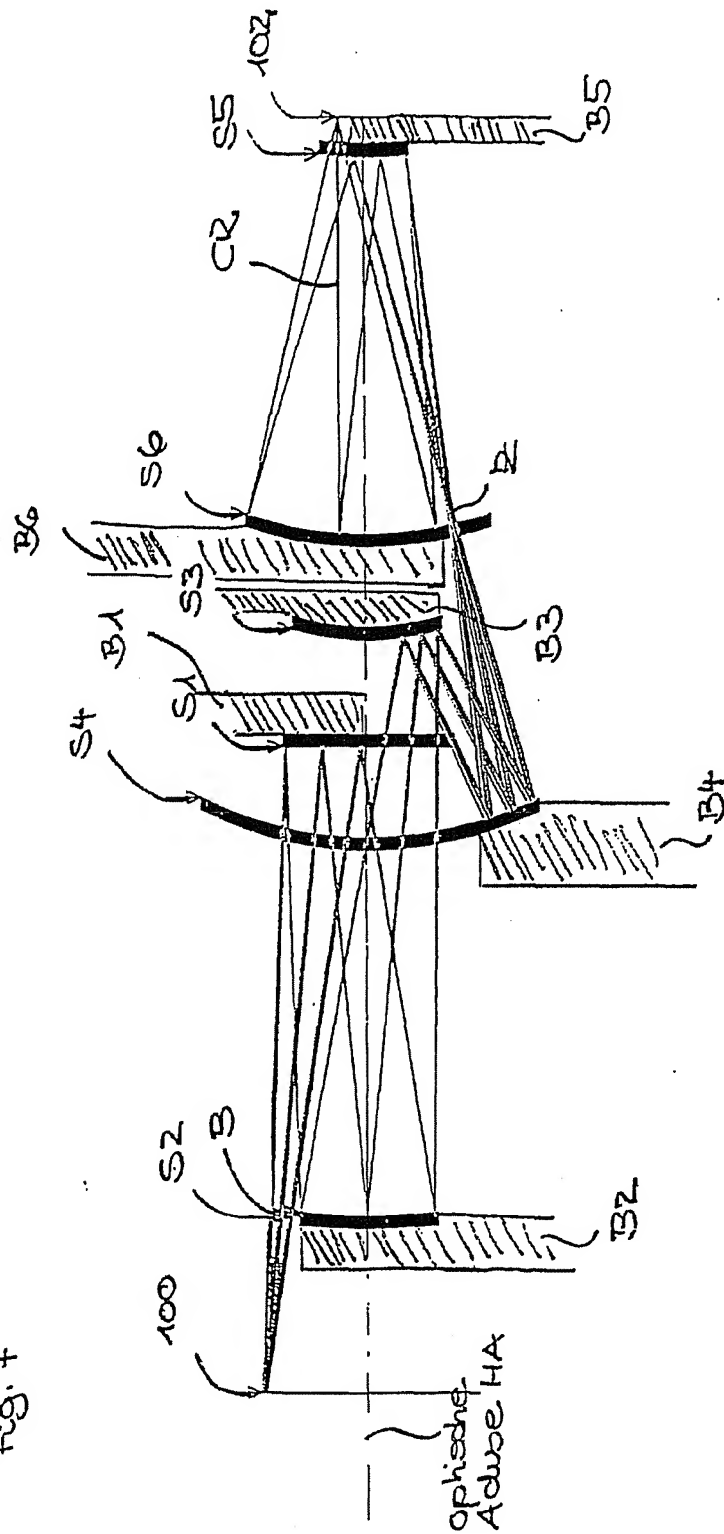


Fig 8

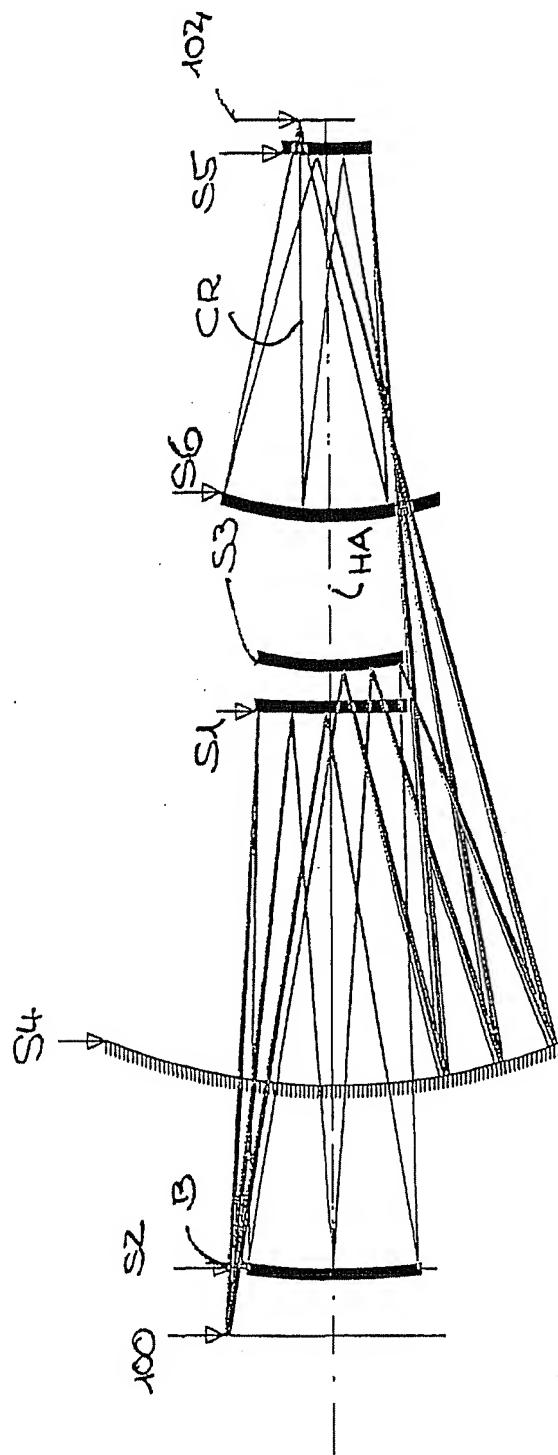


FIG. 9

